硫氰化物化学镀金工艺的研究*

迟兰洲** 胡文成 (电子科技大学应用化学系 成都 610054)

【摘要】 研究了以硫氰化物为络合剂,次亚磷酸盐为还原剂的新型无氰化学镀金工艺,探讨了各 因素对化学镀金镀速的影响关系,并得出最佳配方及工艺条件,在最佳条件下,镀速可达到2.95 μm/h, 镀层质量优良。

关 键 词 无氰化学镀金;硫氰化物;镀速;次亚磷酸盐 中图分类号 TN153.18; TQ153.1

化学镀是在催化表面的作用下[1],通过氧化还原反应产生金属沉积的过程,与电镀相比,它具 有镀层厚度均匀,外观良好,不需要复杂设备和操作简单等优点,随着对超大规模集成电路、元器件 线路微型化要求的提高,化学镀技术更是得到了极大的发展,化学镀金由于其优越的镀层性能,成 为化学镀的一个重要分枝。

迄今为止的化学镀金工艺有含氰化学镀金[2,3]和无氰化学镀金[4]。含氰化学镀金是以氰化物为 络合剂,硼氢化物为还原剂,其镀速和镀液的分散性、稳定性都可保证。然而由于氧化物的剧毒性, 给操作安全、废液处理及环保带来诸多问题,其应用受到一定限制。

无氰化学镀金大致有亚硫酸盐镀金、卤化物镀金、硫代硫酸盐镀金。亚硫酸盐镀金和硫代硫酸 盐镀金均要求 S²⁻作还原剂,S²⁻被氧化产物是单质硫,它沉积在镀件上将影响镀件质量,阻碍反应 的进行。卤化物镀金由于络合能力差,镀液稳定性和分散性难以保证,限制了生产中的应用。文中探 讨了硫氰化钾作络合剂的无氰化学镀金。

实验原理

在化学镀金溶液中,络合剂的作用是与金离子形成稳定的络合物,使溶液中的金离子稳定在较 小的范围。化学镀金溶液中常用络合剂和金离子形成的络合物的 pK 值,如表1所示

合 金离子 NH_3 CN-Cl-SCN-Br-Au⁺ 27.0 38.3 9.42 12.46 17.0 Au³⁺ 30 56 26 31.5 42

表1 络合剂与金离子的 PK 值

从表中可以看出,除 CN-外,SCN-的稳定常数最大,故选择 SCN-作为络合剂是一次可行的尝试。

1995年2月24日收稿,1995年3月17日修改定稿

- * 电子部预研基金资助项目
- * * 男 56岁 大学 副教授

从表中可以看出,除 CN-外,SCN-的稳定常数最大,故选择 SCN-作为络合剂是一次可行的尝试。 以次亚磷酸盐为还原剂、硫氰化物为络合剂的化学镀金,其总反应方程为

$$\frac{1}{3} Au(SCN)_{4}^{-} + \frac{1}{2} H_{2}PO_{2}^{-} + OH^{-} \rightarrow \frac{1}{2} H_{2}PO_{3}^{-} + \frac{1}{3} Au + \frac{1}{2} H_{2}O + \frac{4}{3} SCN^{-}$$

从热力学来分析,化学镀金包括一个阴极过程和一个阳极过程。

阴极
$$\frac{1}{3}$$
Au(SCN) $_{4}^{-}$ + e $\Rightarrow \frac{1}{3}$ Au + $\frac{4}{3}$ SCN $_{1}^{-}$ $E_{1}^{8} = 0.480 \text{ V}$

阳极
$$\frac{1}{2}H_2PO_3^- + \frac{1}{2}H_2O + e \rightleftharpoons \frac{1}{2}H_2PO_2^- + OH^ E_2^0 = -1.565 \text{ V}$$

总反应的标准电位 $E''=E_1''-E_2''=2$. 045 V,自由能变化 $\Delta G=-nFE''=-199$. 04 kJ. mol^{-1} ,从 $\Delta G=-nFE''=-199$. - RTInk® 得 k®=7.76×1034,由此可说明此反应可以进行。

实验及实验结果 2

2.1 工艺流程

实验采用镍件进行化学镀金,为避免置换反应对正交实验的干扰,先在镍基上镀金打底,然后 进行实验化学镀金,其工艺流程为

镍件→除油→浸酸→镀金→金件→正交实验化→镀金→后处理

2.2 正交实验

本次无氰化学镀金溶液的主要成分有:金盐,硫氰化钾,次亚磷酸钠和氯化铵。各组分的作用 为:

金盐:镀液的主盐,提供金离子。

硫氰化钾:镀液的络合剂,与镀液中的金离子形成稳定的络合物,防止镀液的自然分解。

次亚磷酸钠:镀液中的还原剂,将镀液中的金离子还原成金原子并沉积到镀件上。

氯化铵:镀液中的 pH 调节剂,它与加入的碱反应形成 NH3-NH7酸碱对,使 pH 值控制在一定 范围。另外,它也是辅助络合剂,从表1中可以看出,NH3和Cl-可与Au3+络合,与SCN-一起形成多 元配体金络离子。

在化学镀金工艺中,温度和 pH 值对镀速也有影响,因此本次正交实验选用六因素、五水平表, 镀速的测定采用增重法。

正交实验结果如表2所示。

将正交实验结果采用极差法处理,处理结果如表3所示(见后一页)。

从极差法处理表中得到的 R 值表明,对硫氰化物化学镀金镀速影响从大到小的因素排列依次 为:E-C-F-B-A-D,其中,影响最为明显的是温度和还原剂次亚磷酸钠,金盐和氯化铵的影响 较小。

最佳条件的选择

金盐是镀液的主盐,是金离子的供给源,金离子提供越多,则镀速将越大。从实验结果也可以看 出,随着金盐浓度的升高,镀速增大,但是总体对镀速的影响较小,综合考虑到成本的原因,官选取 3.5 g/L 为金盐的最佳浓度值。

硫氰化钾是镀液的络合剂,络合剂的量太小,金离子络合不完全,镀液的稳定性较差,络合剂的 量太大,则游离的金离子太少,镀速降低,从实验结果也可以得出这样的结论,所以硫氰化钾的最佳

浓度宜选取 6 g/L。

表2 正交实验结果表

	金盐/g·L-1	KSCN/g•L ⁻¹	NaH ₂ PO ₂ • H ₂ O/g • L ⁻¹	NH4Cl/g•L ⁻¹	T/℃	пН	
萼	32.m2 8 =	1201/62	1141102 1120/8 2	тинел/ в 2	1, 0	pri	
1	2. 5	3	5	15	30	7.0	1. 62
2	2. 5	4	10	20	40	7.5	1. 71
3	2. 5	5	15	25	50	8.0	1. 86
4	2. 5	6	20	30	60	8.5	2. 18
5	2. 5	7	25	35	70	9.0	2. 40
6	3. 0	3	10	25	60	9.0	2. 28
7	3. 0	4	15	30	70	7.0	2. 44
8	3. 0	5	20	35	30	7.5	1. 83
9	3. 0	6	25	15	40	8.0	1. 56
10	3. 0	7	5	20	50	8.5	1. 76
11	3. 5	3	15	35	40	8. 5	1.74
12	3. 5	4	20	15	50	9.0	1. 85
13	3. 5	5	25	20	60	7.0	2. 23
14	3. 5	6	5	25	70	7.5	2. 48
15	3. 5	77	10	30	30	8.0	1.73
16	4.0	3	20	20	70	8.0	2. 36
17	4. 0	4	25	25	30	8.5	1.75
18	4. 0	5	5	30	40	9.0	1. 89
19	4. 0	6	10	35	50	7. 0	2. 17
20	4. 0	7	15	15	60	7. 5	1. 92
21	4. 5	3	25	30	50	7.5	1. 97
22	4. 5	4	5	35	60	8.0	2. 38
23	4. 5	5	10	15	70	8. 5	2, 20
24	4.5	6	15	20	30	9.0	1. 79
25	4. 5	7	20	25	40	7. 0	1.83

表3 极差法处理表

_			因 素			
K	A 金盐	B KSCN	C NaH ₂ PO ₂ •H ₂ O	D NH ₄ Cl	<u>Е</u> Т	F pH
K_1	9. 77	9. 97	9. 15	10. 13	8. 72	10. 29
K_2	9. 87	10. 13	9. 85	10.09	8. 73	9. 91
K3	10. 03	10. 01	10. 20	9. 75	9. 61	9. 89
K_4	10. 09	10. 18	10. 21	10.05	10. 99	9. 63
K_5	10. 17	9. 64	10. 52	9. 91	11. 88	10. 21
\boldsymbol{k}_1	1. 954	1. 994	1. 830	2. 026	1.744	2. 058
k_2	1. 974	2. 026	1. 970	2. 018	1.746	1. 982
k ₃	2. 006	2. 002	2. 040	1. 950	1. 922	1. 978
k_4	2. 018	2. 036	2. 042	2. 010	2. 198	1. 926
k 5	2. 034	1. 928	2. 104	1. 982	2. 376	2. 042
R	0. 080	0. 108	0. 274	0. 076	0, 632	0. 132

次亚磷酸钠是镀液的还原剂,还原剂的量太小,则金的析出速度较低,还原剂过高,镀液易发生分解,镀速将下降,从实验结果得出次亚磷酸钠的最佳浓度为 20 g/L。

氯化铵是辅助络合剂和 pH 值调节剂,对镀速的影响总的趋势是减小,但幅度较小。从实验结果也看出对镀速的影响最小,宜选取 15 g/L 为最佳值。

温度对化学反应速率的影响较明显,随着温度的升高,反应速度加快,对化学镀金来说沉积速度将增大。从实验也可以看出温度对镀速影响最大,温度越高,镀速增大,但温度过高,将严重影响镀液的稳定性,所以,温度选择 $70 \, ^{\circ}$ 为宜。

从化学镀金总的反应方程式来看,OH⁻作为反应物参加化学反应,按道理 pH 值越高,镀速将越大,但是实验结果却是随着 pH 值升高,镀速降低,这主要是 pH 越高,OH⁻浓度增大,镀液稳定性降低,使镀速降低。另外,如果 pH 值过低,OH⁻浓度太小,镀速也将减小,所以 pH 值的最佳值宜选取 7。

通过正交实验的结果及对各因素的具体讨论,可以得出硫氰化物化学镀金的最佳配方及工艺条件:

金盐 3.5 g/L KSCN 6 g/L NaH₂POs2•H₂O 20 g/L

NH₄Cl 15 g/L 温度 70℃ pH 值

将上述配方在最佳工艺条件下进行施镀,得到的镀速为2.95 μm/h,镀液稳定性良好,且镀层质量优异,连续施镀可达到五个周期。

4 结 论

文中通过正交实验研究了以硫氰化物为络合剂,次亚磷酸钠为还原剂的无氰化学镀金镀速与 各因素的影响关系,在综合考虑镀速、镀液稳定性和节约的原则,得出最佳配方及工艺条件:

金盐 3.5 g/L KSCN 6 g/L NaHPOs2·H₂O 20 g/L

NH₄Cl 15 g/L 温度 7 ℃ pH 值 7

在该条件下镀速可达2.95 μm/h,镀液稳定,镀层质量优良,连续施镀可达到五个周期。

参考文献

- 1 伍学高编著. 化学镀技术. 成都:四川科技出版社,1985,11:1~6
- 2 Mathe Zoltan. Electroless of autocatalytic gold plating. Metal Finishing, 1992, 90(1):33~40
- 3 Okinaka Y. Electroless gold deposition using borohydride or dimethylamine borane as reducing agent. Plating, 1970,57(9):914~920
- 4 迟兰洲,胡文成,陈瑞生. 无氰化学镀金镀速及稳定性的研究. 表面技术,1994,23(1):12~15

Study on Technology of Electroless Gold Plating Using Thiocyanate as Chelate

Chi Lanzhou Hu Wencheng
(Dept. of Appl. Chem. , UEST of China Chengdu 610054)

Abstract Electroless gold plating using sodium hypophosphite as reducing and potassium thiocyanate as chelate is studied in this paper. Electroless gold plating bath which contains $AuCl_3$, KSCN, NH_4Cl and $NaH_2PO_2 \cdot H_2O$ is developed through orthogonal experiment. This bath is excellent in service life, satbility, plating rate and deposit surface in optimum conditions when $AuCl_3$, KSCN, NH_4Cl , $NaH_2PO_2 \cdot H_2O$ are 3. 5 g/L, 6 g/L, 15 g/L and 20 g/L, pH7 respectively and the temperature is $70^{\circ}C$.

Key words electroless gold plating; thiocyanate; plating rate; hypophosphite

编辑 徐培红

·科研成果介绍·

直接序列扩频通信检测与参数估计

主研人员:郭 伟 余敬东 张国平 李少谦 洪福明 夏超时 李 牧

首次提出了 DS/SS 信号的数字滑动窗积分自相关检测模型,利用该模型建立的实验系统,对信噪比在—10 dB 左右仍能实现检测和参数估计,具有理论和实际应用价值。首次提出了 DS/SS 信号无损窄带干扰自适应抑制技术,研制出多功能直扩信号源和干扰、噪声源,该多功能信号源能输出码长、码速可调的直扩信号,以及信噪比和信干比可调的直扩、干扰、噪声混合信号,供科研实验用。

34GDS-4型光纤传输设备

主研人员: 张志清 李乐民 邱培曦 吕道富 唐绍淑 曾大章 薛光盛 黄宋耀 李致启 张 翔 倪道友 赵岳均 张 驿 徐寄森

实用化三次群光纤通信系统是国家"七五"攻关项目。该系统在保定一北京、蚌埠一水家湖、南京一芜湖、南昌一向塘等地区应用,用户反映很好。电子科技大学承担了关键技术一线路编解码与上、下区间通信以及全线监控等研制,包括快速帧同步、复接、分接、码速调整与恢复、微机监控等。

科卞